

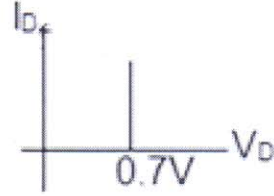
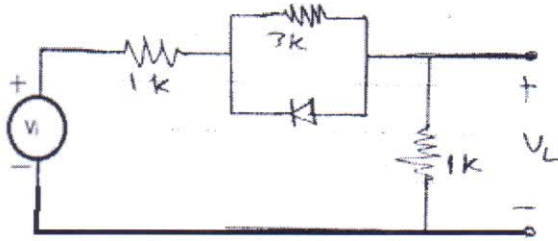
أجب عن جميع الأسئلة التالية (4 أسئلة - 60 درجة)

السؤال الأول اكتب تفسيراً فيزيائياً لكل من: (10 درجات)

- 1- عدم الخطية في منحنى خصائص الثنائي الحقيقي.
- 2- عادة ما يتم تقسيم مقاومة دخل الترانزستور (R_B) إلى R_{B1} و R_{B2} .
- 3- وضع مكثف على التوازي مع المقاومة (R_E) يحسن من أداء المضخم مع المحافظة على الاستقرار.
- 4- حدوث تحصر في تدفق التيار في الترانزستور E_MOSFET مع ازدياد جهد المصدر وثبوت جهد البوابة.
- 5- لا يتم حساب كسب التيار في مكبرات الإشارة عند استخدام ترانزستور تأثير المجال بأنواعه المختلفة.

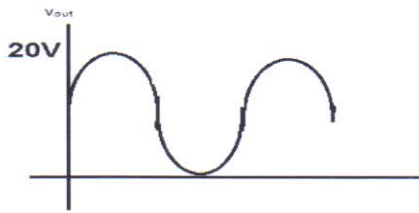
السؤال الثاني (15 درجة)

أ- أوجد جهد الخرج للدائرة التالية. اعتبر خواص الثنائي التالية:

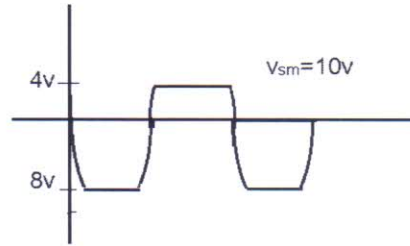


ب- ارسم الدوائر اللازمة لإنتاج الإشارات التالية لموجة دخل $v_i = 10 \sin \omega t$:

A



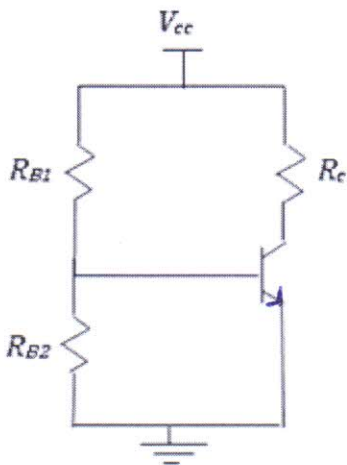
B



السؤال الثالث (18 درجة)

في دائرة الباعث المشترك المقابلة أوجد:

- 1- قيم مقاومة القاعدة (R_{BB}) والجهد (V_{BB}) المكافئ،
- 2- إحداثيات نقطة التشغيل (V_{CEQ} , I_{CQ}).
- 3- ارسم خط الحمل ونقطة التشغيل مع كتابة البيانات.
- 4- ما هي القيمة المثلى لـ V_{CEQ} ؟



$$V_{cc} = 20 V$$

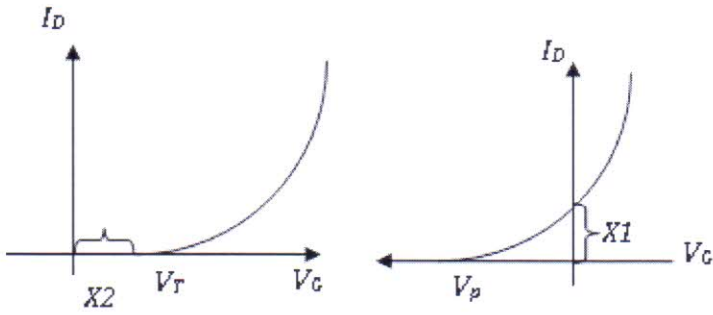
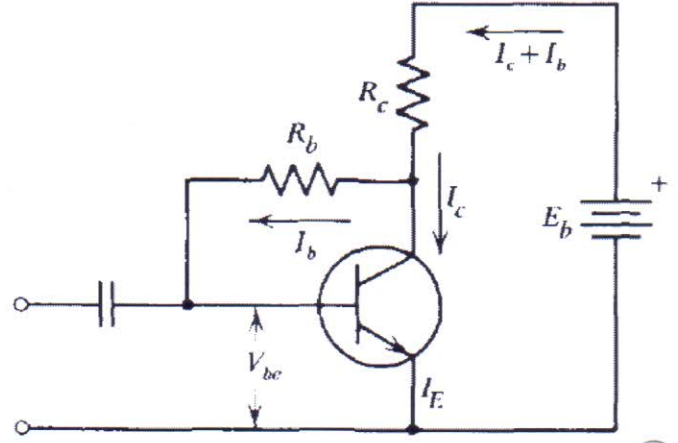
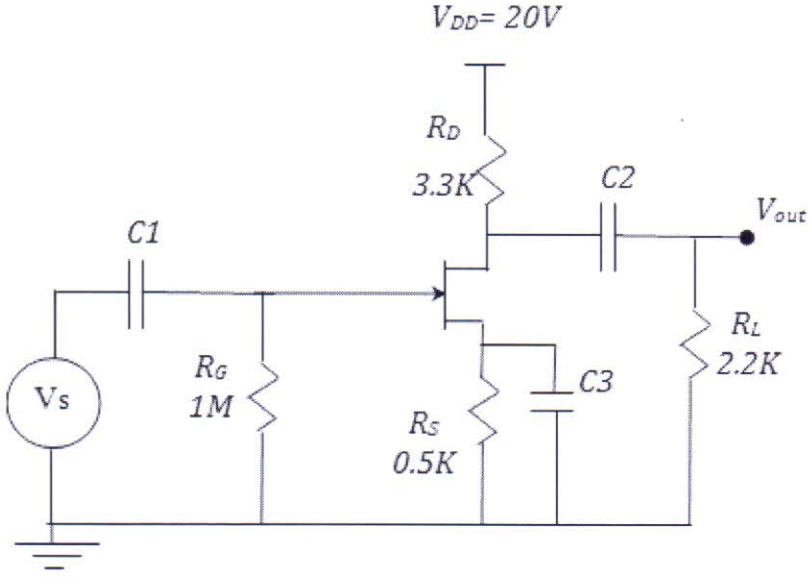
$$B_{dc} = 200$$

$$R_{B1} = 2M$$

$$R_{B2} = 1.2M$$

$$R_C = 4K$$

أ- ارسم الدائرة المكافئة مع الإشارة الصغيرة للمضخمين التاليين:



ب- من خلال الرسم البياني التالي أجب عن ما يلي:

- ما نوع الترانزستور لكل منهما.
- بماذا تفسر كل من المسافة X1 و X2؟
- ما تفسير عدم الخطية في هذه المنحنيات؟

انتهت الأسئلة،،،

أتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد